

# 第13回 日本表面科学会中部支部 学術講演会プログラム

2013年12月21日(土) 9:45~16:55 名古屋工業大学 2号館C棟2階 11(アイ1)教室

	講演者	所属	学年	講演題目
9:45 - 9:50	支部長挨拶 (豊田工業大学 大学院工学研究科 吉村雅満)			
9:50 - 10:05	1 高木 将樹	豊田工大院	M1	銅化合物で修飾した酸化タングステンの光触媒活性
10:05 - 10:20	2 太田 紘志	静岡大院・工	M1	色素増感太陽電池のための酸化チタン表面における増感色素吸着の研究 PDC 分子によるN719 色素の吸着量増加
10:20 - 10:35	3 Rangga Winatyo	静岡大 創造科学技術大学院	D3	Increase in the open circuit voltage of aligned ZnO nanorods-based dye sensitized solar cells
10:35 - 10:50	4 矢野 航	名古屋工大院・機能工学	M1	ドライプロセスによる有機-無機接合アクチュエータの作製と変位電圧特性の評価
10:50 - 11:00	休憩(10分)			
11:00 - 11:15	5 岩辺 あい	静岡大学・工	B4	表面ナノ構造によるTMP 分子の挙動制限に関する研究
11:15 - 11:30	6 伊藤 嵩人	名古屋工大・工	B4	表面張力を駆動力としたマイクロ流路の構造最適化
11:30 - 11:45	7 Laura Tiong	山梨大学	M1	Energy Conversion of Microalgae (Chlorella vulgaris) with Catalytic Supercritical Water Gasification
11:45 - 12:00	8 川村 亮平	名古屋工大院	M1	両親媒性分子のプラズマ照射により作製した重合薄膜のナノ構造解析
12:00 - 13:00	昼食(60分)			
13:00 - 13:45	宮崎 誠一 先生	名古屋大学	【チュートリアル講演】半導体-金属 接触界面の構造について	
13:45 - 14:00	9 DENG Yunsheng	名古屋大院・工	D3	Epitaxial formation and electrical property of Ni Germanide/Ge(110) contact
14:00 - 14:15	10 荒井 崇	名古屋大院・工	M1	SiO <sub>x</sub> /TiO <sub>2</sub> 積層した Ti 電極 MIMダイオードの抵抗 スwitchング
14:15 - 14:25	休憩(10分)			
14:25 - 14:40	11 新田 高洋	岐阜大学・工	助教	摩擦界面その場観察によって明らかとなった巨視的滑り運動と接触領域で起こる剥離の関係
14:40 - 14:55	12 張 海	名古屋大院・工	D2	リモート水素プラズマ支援によるSiO <sub>2</sub> 上へのFe ナノドットの高密度・一括形成
14:55 - 15:10	13 竹内 和歌奈	名古屋大院・工	助教	低温固相成長Ge へのSn 導入による正孔移動度の向上
15:10 - 15:25	14 鈴木 悠平	静岡大院・工	M1	Ga イオン注入による P ドープ 薄膜 SOI層のゼーベック係数の変化
15:25 - 15:40	15 池 進一	名古屋大院・工	M2	高輝度放射光X 線マイクロ回折法によるGe <sub>1-x</sub> Sn <sub>x</sub> /Ge 微細構造内部の局所歪評価
15:40 - 15:50	休憩(10分)			
15:50 - 16:05	16 寺島 辰也	名古屋大院・工	M2	Ge <sub>1-x-y</sub> Si <sub>x</sub> Sn <sub>y</sub> エピタキシャル層の結晶構造の成長温度および熱処理依存性
16:05 - 16:20	17 木戸脇 翔平	名古屋大院・工	M2	Si(110)上 Ge <sub>1-x</sub> Sn <sub>x</sub> エピタキシャル薄膜の成長機構および転位構造
16:20 - 16:35	18 大原 穂波	名古屋大院・工	M2	SiC(000-1)C面上における均一な大面積グラフェンの作製と評価
16:35 - 16:50	19 藤田 隼	名古屋大院・工	M2	高配向・高密度カーボンナノチューブ膜へのカルボラン内包とその評価
16:50 - 16:55	副支部長挨拶 (静岡大学 大学院工学研究科 村上 健司)			
17:30	懇親会(会費:一般4,000円, 学生1,000円, 講演者無料 @名古屋工業大学 大会館)			

※講演はすべて液晶プロジェクターを使用します。時間は15分です。(発表10分, 質疑応答5分)

第1鈴:8分, 第2鈴:10分, 第3鈴:15分

※懇親会にて講演奨励賞授与を行います。講演者はできるだけ参加してください。